ФОНОНЫ, МАГНОНЫ И ЭКСИТОНЫ В НЕЦЕНТРОСИММЕТРИЧНОМ МАГНИТОЭЛЕКТРИКЕ – АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ СиВ₂О₄

Р. В. Писарев^{*}, Р. М. Дубровин

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 194021, Санкт-Петербург, Россия

> Поступила в редакцию 30 марта 2023 г., после переработки 30 марта 2023 г. Принята к публикации 7 апреля 2023 г.

В последние два десятилетия метаборат меди CuB_2O_4 с уникальной нецентросимметричной кристаллической структурой стал предметом активных исследований, что было связано с обнаружением в нем необычных магнитных и оптических свойств. Рассмотрены особенности распространения и поглощения света в CuB_2O_4 на основе решения уравнений Максвелла. Представлен обзор основных результатов по исследованию фононного спектра с применением методов инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света. Исследования в области электронных переходов в ионах Cu^{2+} в кристаллическом поле позволили провести разделения вкладов в оптическое поглощения в магнитном в неэквивалентных позициях. Обнаружено расщепление бесфононных линий поглощения в магнитном поле, и эти результаты получили теоретическое объяснение в рамках экситонной модели. В спектрах фотолюминесценции наблюдалась богатая структура экситон-магнонных состояний. Проведено спектроскопическое исследование второй оптической гармоники в области экситонных переходов, что позволило выявить роль тороидного момента и резонанса Фано в наблюдаемые сигналы.

EDN: XMJAFW

Статья для специального выпуска ЖЭТФ, посвященного 95-летию Л. А. Прозоровой

DOI: 10.31857/S004445102310019X

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	673
2. Кристаллическая и магнитные струк-	
туры	674
2.1. Кристаллическая структура	674
2.2. Магнитная фазовая диаграмма	675
3. Распространение и поглощение света .	677
4. Динамика кристаллической решетки	679
4.1. Инфракрасная спектроскопия	679
4.2. Комбинационное рассеяние света	680
4.3. Возбуждение когерентных фононов	681
5. Электронная структура и онов Cu^{2+}	682

1. ВВЕДЕНИЕ

Метаборат меди с химической формулой CuB₂O₄, или в другой записи двойной оксид

 ^{5.1.} Расщепление электронных уровней иона
 682

 Cu²⁺
 682

 5.2. Поглощение в области переходов между
 3d⁹-состояниями

 3d⁹-состояниями
 682

 5.3. Невзаимность оптического поглощения
 684

 5.4. Экситоны Френкеля
 685

 6. Фотолюминесценция
 687

 7. Вторая оптическая гармоника
 689

 8. Заключение
 692

 Литература
 693

^{*} E-mail: pisarev@mail.ioffe.ru

меди и бора CuO·B₂O₃, известен уже более ста лет [1]. Однако его кристаллическая структура была расшифрована много позднее [2], а активные исследования магнитных, оптических и магнитооптических свойств ведутся только в последние два десятилетия. Интерес к изучению CuB₂O₄ был в большой степени вызван такими факторами, как необычная для многочисленных разновалентных оксидов меди, и вообще для магнитных материалов, кристаллическая структура, наличие при низких температурах нескольких магнитоупорядоченных фаз, его необычными оптическими спектрами в области 3d⁹-электронных переходов и большая ширина запрещенной зоны с краем поглощения в районе 4 эВ, что заметно больше, чем в большинстве магнитных оксидов. К настоящему времени число публикаций по различным свойствам CuB₂O₄ можно приблизительно оценить цифрой в несколько сотен, но в этой статье будут рассмотрены преимущественно результаты по его оптическим и магнитооптическим свойствам.

Статья построена следующим образом. В разд. 2 дается краткий обзор по кристаллической структуре и основным статическим магнитным свойствам метабората меди, знание которых абсолютно необходимо для обоснованной интерпретации оптических и магнитооптических проявлений электронной структуры $3d^9$ -состояний иона Cu^{2+} в кристаллическом поле. В разд. 3 рассмотрены основные результаты теоретического макроскопического анализа особенностей распространения света на основе решений уравнений Максвелла с учетом особенностей кристаллической и магнитной структур. В разд. 4 дан обзор результатов исследований оптических фононов, выполненных с использованием инфракрасной (ИК) спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС). Показано, что экспериментальные результаты находятся в хорошем согласии с первопринципными расчетами фононов в центре зоны Бриллюэна. В разд. 5 проанализированы особенности расщепления 3d⁹-электронных состояний магнитных ионов Cu²⁺ и во многом необычное проявление этого расщепления в оптическом поглощении. В этом же разд. 5 показана недостаточность теории кристаллического поля для описания особенностей тонкой структуры спектров поглощения в магнитном поле. Для их объяснения потребовалось проведение теоретического анализа на основе концепции экситонов Френкеля. В разд. 6 приведены результаты изучения необычной для магнитоупорядоченных кристаллов вообще и для иона Cu²⁺ в частности фотолюминесценции. В разд. 7 приведены основные результаты спектроскопического исследование генерации второй оптической гармоники (ГВГ) в области экситонных переходов.

2. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ И МАГНИТНЫЕ СТРУКТУРЫ

2.1. Кристаллическая структура

Кристаллическая структура CuB₂O₄ описывается редкой для магнитоупорядоченных оксидов нецентросимметричной точечной группой $\overline{4}2m$ и пространственной группой $I\overline{4}2d$ [2, 5]. Из других магнитных материалов с такой же структурой существует, по-видимому, только метаборат палладия PdB_2O_4 [6,7]. Следует отметить, что несмотря на одинаковые структуры, в метаборате меди магнитный ион Cu^{2+} имеет электронную оболочку $3d^9$ и спин S = 1/2, а в метаборате палладия ион Pd^{2+} имеет оболочку $4d^8$ и спин S = 1. Можно предполагать, что эти различия в строении электронных оболочек Cu²⁺ и Pd²⁺ должны проявиться в существенном различии магнитных и оптических свойств этих двух материалов, но, в отличие от метабората меди, сообщения о каких-либо свойствах метабората палладия фактически отсутствуют.

Элементарная ячейка CuB₂O₄ содержит двенадцать формульных единиц (Z = 12), и на рис. 1 показаны две трехмерные проекции ячейки вдоль тетрагональной оси $c(z) \parallel [001] [3,4]$. Магнитные и оптические свойства метабората меди определяются двенадцатью ионами двухвалентной меди Cu²⁺, которые занимают в ячейке две неэквивалентные кристаллографические позиции 4b и 8d. В позициях 4b с локальной осью $\overline{4}$ ионы Cu^{2+} окружены четырьмя ближайшими ионами кислорода О²⁻, а ионы Cu²⁺ находятся в центре и на боковых гранях ячейки (рис. 1). В позициях 8d с локальной осью симметрии второго порядка 2 все восемь ионов Cu²⁺ находятся внутри ячейки. Они окружены четырьмя ближайшими кислородными соседями на типичном для $3d^n$ -оксидов расстоянии ~ 1.9 Å, но в дополнение к ним на аномально большом расстоянии около 3 Å находятся еще два апикальных иона O^{2-} . Остальное пространство внутри ячейки занимают бор-кислородные тетраэдры ВО₄, соединяющие ионы меди в обеих позициях. Наличие ионов Cu²⁺ в двух неэквивалентных позициях хорошо проявляется как в их магнитном поведении, и так в оптических электронных спектрах, что будет рассмотрено в разд. 5.



Рис. 1. (Цветной онлайн) Две трехмерные проекции элементарной ячейки CuB₂O₄ вдоль тетрагональной оси *c*(*z*) ∥ [001] с осью симметрии 4; слева с тетраэдрами ВO₄, справа без тетраэдров. Два типа тетраэдров B1O4 и B2O4 показаны синим и голубым цветом, соответственно. Все ионы Cu²⁺ в 4*b*-позициях расположены в центре (CuA1) и на боковых гранях (CuA2) ячейки, а все ионы Cu²⁺ в 8*d*-позициях находятся внутри ячейки. Рисунки приведены согласно статьям [3] и [4] с разрешения American Physical Society и MDPI

С начала двадцатого века считалось, что метаборат меди, как химическое соединение, может быть синтезирован лишь искусственно [1]. Однако сравнительно недавно в 2008 г. в чилийской пустыне был обнаружен минерал сантарозаит (santarosaite) [8]. Этот минерал имеет химическую формулу CuB₂O₄ и такую же кристаллическую структуру, как и искусственное соединение. Уникальность структуры кристалла CuB₂O₄ заключается в том, что его химически-эквивалентные метабораты типа AB₂O₄, в которых A²⁺-ион есть какой-либо другой двухвалентный $3d^n$ -ион, как, например, Mn^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} и др., кристаллизуются в группах, отличных от $I\overline{4}2m$. Но следует все же отметить, что имеются публикации о сохранении структуры I42d при небольшом замещении в CuB_2O_4 ионов Cu^{2+} ионами Ni^{2+} (оболочка $3d^8$, спин S = 1) и ионами Mn^{2+} (оболочка $3d^5$, спин S = 5/2) [9–12]. Можно предположить, что эта стабильность структуры CuB₂O₄ связана с эффектом Яна-Теллера, имеющим место для иона Cu²⁺ в кристаллах [13]. Тогда можно понять, почему соединения АВ₂О₄, где ионы А²⁺ не являются ян-теллеровскими ионами, не кристаллизуются в структуре $I\overline{4}2m$. Если это так, то возникает вопрос, не может ли существовать соединение CrB₂O₄ со структурой CuB_2O_4 , поскольку ион Cr^{2+} (оболочка $3d^4$) также является ян-теллеровским ионом [13]. Другой известный сложный борат меди Cu₃B₂O₆ кристаллизуется в низкосимметричной пространственной группе $P\overline{1}$ [14,15]. Из недавних сообщений можно отметить более сложные по составу и структуре бораты меди Cu_2MBO_5 , где M = Cr, Fe, Mn [16].

2.2. Магнитная фазовая диаграмма

Исследование магнитных фаз в CuB₂O₄ в нулевом поле с использованием рассеяния неполяризованных и поляризованных нейтронов было проведено в работе [17]. При температуре Нееля $T_N = 21$ К (в ряде работ называется величина $T_N = 20$ K) наблюдался переход из парамагнитного в соразмерное антиферромагнитное состояние со слабым ферромагнетизмом. При температуре около $T^* \sim 10 \ {
m K}$ (в ряде работ называются несколько другие значения Т*) наблюдался еще один магнитный фазовый переход в несоразмерную магнитную структуру, при этом ниже T* были обнаружены необычные асимметричные магнитные спутниковые отражения. Изменение магнитного состояния наблюдалось также при температуре $T^{**} \sim 1.8$ К. Важным результатом этого низкотемпературного нейтронного исследования явилось то, что только в 4bподсистеме меди можно было говорить о полном магнитном упорядочении, а 8*d*-подсистема оставалась лишь частично упорядоченной вплоть до самых низких температур. Такие сложные изменения магнитного состояния бората меди в зависимости от температуры были предположительно объяснены взаимодействием двух неэквивалентных магнитных 4b- и 8d-подсистем меди. Следует еще отме-



Рис. 2. (Цветной онлайн) Магнитные фазовые диаграммы CuB₂O₄ для направления внешнего магнитного поля H вдоль тетрагональной оси (слева) и перпендикулярно к этой оси (справа). Эти диаграммы показывают, что, в зависимости от величины поля и температуры, магнитная структура характеризуется различными антиферромагнитными фазами AF₀, AF₀, AF₁ и несоразмерными фазами P₃, P₂, P₁. T_{ср} обозначает трикритическую точку при температуре ~ 6 K в поле ~ 0.3 Тл. Рисунки приведены согласно статье [18] с разрешения ЖЭТФ

тить наблюдение в борате меди диффузного рассеяния нейтронов в широком температурном диапазоне 1.5 K < T < 30 K, т.е. существенно выше температуры магнитного упорядочения $T_N = 21 \text{ K}$ [17].

Результаты подробного исследования фазовой диаграммы CuB₂O₄ в магнитном поле были опубликованы в недавних статьях [18, 19], в которых можно найти многочисленные ссылки на более ранние работы по этой теме. На рис. 2 показаны диаграммы для двух основных направлений магнитного поля вдоль тетрагональной оси $c(z) \parallel [001]$ и перпендикулярной к ней оси $a(x) \parallel [100]$ [18]. Диаграммы существенно отличаются для двух ориентаций поля. Ниже $T_N = 20$ К диаграммы характеризуется множеством соразмерных и несоразмерных магнитных фаз, что сильнее проявляется при ориентации магнитного поля в плоскости (001), как это видно справа на рис. 2. Ориентационные фазовые переходы разного типа между этими магнитными фазами наблюдаются уже в очень слабых магнитных полях. И напротив, при ориентации поля вдоль тетрагональной оси c(z) при низких температурах переходы могут иметь место даже в полях порядка $H_{\rm crit} \sim 8$ Тл, как это видно слева на рис. 2. Столь сложные и анизотропные магнитные фазовые диаграммы свидетельствуют о том, что в CuB₂O₄ имеет место конкуренция между большим числом параметров, влияющих на взаимодействие внутри 4bи 8d-подсистем и между ними. Теоретический анализ изотропных и анизотропных взаимодействий в двух магнитных подсистемах и несоразмерных магнитных структур проводился в работах [20–22].

ния параметров элементарной ячейки и диэлектрической проницаемости СиВ₂О₄ вдоль главных кристаллографических направлений в области температур от 5 до 35 К. Эта область включает магнитные фазовые переходы при $T_N = 21$ К и $T^* \sim 10$ К, но никаких аномальных изменений параметров при этих переходах не было обнаружено. Поскольку симметрия допускает возможность в CuB₂O₄ линейного магнитоэлектрического взаимодействия, можно было бы ожидать появления аномального пика диэлектрической проницаемости при магнитных переходах. Авторы статьи [23] предположительно объяснили отсутствие аномалий слабостью магнитоэлектрического взаимодействия. Действительно, в теоретической работе [24] было показано, что в чистом кристалле CuB₂O₄ магнитоэлектрическое взаимодействие ожидается очень слабым, но должно усиливаться при легировании CuB₂O₄ двухвалентными ионами Ni²⁺.

В работе [23] изучались температурные измене-

Теоретический анализ динамического магнитоэлектрического взаимодействия в CuB_2O_4 был дан в статье [25]. Отметим, что вопрос об экспериментальном обнаружении аномалий диэлектрической проницаемости при фазовых переходах как в чистом CuB_2O_4 , так и в легированном двухвалентными магнитными $3d^n$ -ионами, пока остается открытым. Еще следует отметить, что магнитные фазовые переходы в CuB_2O_4 хорошо проявляются в теплопроводности [19], которая в первую очередь определяется фононной подсистемой, и этот результат может свидетельствовать о сильной спин-фононной связи в CuB_2O_4 .

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА

В экспериментальной статье [26] было заявлено о наблюдении изменения резонансного поглощения света в CuB₂O₄ при изменении ориентации магнитного поля, что было интерпретировано как обнаружение «магнитной хиральности». В кристаллохимии и кристаллофизике под хиральностью молекулы или кристалла понимают невозможность совмещения объекта с его зеркальным отражением [27]. Наглядным примером хиральных объектов являются правая и левая рука, которые невозможно совместить никакими операциями симметрии. Кристаллический кварц может быть левым и правым, но обе эти модификации описываются одной тригональной точечной группой 32 (D₃), и поэтому для описания симметрийного различия между ними необходимо рассматривать две пространственные группы РЗ₁21 и РЗ₂21 [28]. В случае кристаллов хиральность определяется распределением электрических зарядов в элементарной ячейке, в которой должны отсутствовать плоскости зеркальной симметрии. Наиболее наглядным проявлением хиральности в кристаллах и молекулах является оптическая активность, т.е. свойство кристалла вызывать вращение плоскости поляризации проходящего через него линейно-поляризованного света [29].

В связи с введением в статье [26] расширенного понятия «магнитной хиральности» следует высказать некоторые замечания, поскольку, по нашему мнению, этот термин содержит в себе противоречие между словами «магнитная» и «хиральность». Как сказано выше, кристаллическая хиральность определяется распределением электрических зарядов. Но магнитное поле есть аксиальный вектор и является не хиральным (виток тока совпадает с его зеркальным отражением). Оно действует на магнитные моменты и спины, но не действует на электрические заряды ионов, и следовательно, никак не может создать или изменить хиральность объекта. Заявленное обнаружение магнитной хиральности [26] было проанализировано в статье [30], где были рассмотрены пять возможных магнитных группы CuB₂O₄ при ориентации магнитного поля вдоль основных осей симметрии, а именно, трех кристаллографических осей элементарной ячейки [100], [010] и [001] (рис. 1), а также двух диагональных осей [110] и [110] в плоскости (001). Магнитные группы во всех этих пяти случаях являются различными, что, естественно, должно проявляться в экспериментальных исследованиях. Проведенный в работе [30] симметрийный анализ был применен

к результатам экспериментальной статьи [26], и было показано, что все пять наборов экспериментальных результатов в статье [26] следует интерпретировать не как проявление «магнитной хиральности», а как проявление хорошо известных магнитооптических эффектов магнитного кругового (циркулярного) дихроизма (MCD), магнитного линейного дихроизма (MLD) и невзаимного линейного дихроизма (NRLD). Эта теоретическая трактовка экспериментальных результатов статьи [26] привела к противоречивой дискуссии, подробности которой можно найти в работах [31–33].

Распространение и поглощение света может быть взаимным и невзаимным. Взаимные явления характеризуется тем, что при распространении «впередназад» в одной и той же среде результат одинаков, а в невзаимных явлениях результат различный. Невзаимные явления наглядно проявляются в магнитооптических эффектах Фарадея и Керра, которые наблюдаются в любом парамагнетике и диамагнетике в присутствии магнитного поля. Ферромагнетики и ферримагнетики характеризуются спонтанными невзаимными явлениями даже в нулевом поле [34], но невзаимность в антиферромагнетиках не является очевидным явлением. Рассмотрим в этом разделе результаты теоретического исследования взаимных и невзаимных оптических явлений в антиферромагнетике CuB₂O₄, которое было проведено с учетом симметрии кристаллической структуры (симметрия пространства) и магнитной структуры (инверсия времени). Задача о распространении света в метаборате меди была рассмотрена с привлечением уравнений Максвелла при использовании разложения тензора диэлектрической проницаемости как функции волнового вектора света k, внешнего магнитного поля \mathbf{B}^0 и антиферромагнитного и ферромагнитного параметров порядка [35]. Такой подход позволил установить основные механизмы и источники взаимных и невзаимных явлений при распространении света в CuB₂O₄.

Рассмотрим сначала кристалл CuB_2O_4 в парамагнитной области, где разложение тензора диэлектрической проницаемости ε_{ij} по малым поправкам можно записать в виде [36]

$$\varepsilon_{ij} \approx \varepsilon_{ij}^{\rm cr} + i\gamma_{ijk}\kappa_k + f_{ijk}B_k^0 + c_{ijkl}\kappa_k B_l^0, \qquad (1)$$

где первый член $\varepsilon_{ij}^{\rm cr}$ соответствует диэлектрической проницаемости без учета возмущений, второй член, линейный по волновому вектору света, отвечает за пространственную дисперсию, третий член отражает вклад магнитного поля, а четвертый член соответствует магнитоиндуцированной пространствен-

	k [100]	k [010]	k [001]
B ⁰ ∥ [100]	$\mathbf{k}_{[100]}^{[010]} = \left(1 - \frac{c_{xxyy}\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{B}^{0}}{2\varepsilon_{xx}^{\mathrm{cr}}}\right) \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\mathrm{cr}} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\kappa}}$	$\mathbf{k}_{[010]}^{[100]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\mathrm{cr}}\mu}\kappa, \ \mathbf{k}_{[010]}^{[001]} = \sqrt{\varepsilon_{zz}^{\mathrm{cr}}\mu}\kappa$	$\mathbf{k}_{[001]}^{[100]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\text{cr}}\mu}\boldsymbol{\kappa}, \ \mathbf{k}_{[001]}^{[010]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\text{cr}}\mu}\boldsymbol{\kappa}$
	$\mathbf{k}_{[100]}^{[001]} = \left(1 + \frac{c_{zzxx}\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{B}^{0}}{2\varepsilon_{zz}^{\mathrm{cr}}}\right) \sqrt{\varepsilon_{zz}^{\mathrm{cr}} \mu} \boldsymbol{\kappa}$		
$\mathbf{B}^0 \parallel [010]$	$\mathbf{k}_{[100]}^{[010]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\mathrm{cr}} \mu} \boldsymbol{\kappa}, \ \mathbf{k}_{[100]}^{[001]} = \sqrt{\varepsilon_{zz}^{\mathrm{cr}} \mu} \boldsymbol{\kappa}$	$\mathbf{k}_{[010]}^{[100]} = \left(1 + \frac{c_{xxyy}\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{B}^{0}}{2\varepsilon_{xx}^{cr}}\right) \sqrt{\varepsilon_{xx}^{cr} \mu \boldsymbol{\kappa}}$	$\mathbf{k}_{[001]}^{[100]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\text{cr}} \mu} \kappa, \ \mathbf{k}_{[001]}^{[100]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\text{cr}} \mu} \kappa$
		$\mathbf{k}_{[010]}^{[001]} = \left(1 - \frac{c_{zzx}\boldsymbol{\kappa} \cdot \mathbf{B}^{0}}{2\varepsilon_{zz}^{\mathrm{cr}}}\right) \sqrt{\varepsilon_{zz}^{\mathrm{cr}} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\kappa}}$	
$\mathbf{B}^0 \parallel [001]$	$\mathbf{k}_{[100]}^{[010]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\text{cr}}\mu}\boldsymbol{\kappa}, \ \mathbf{k}_{[100]}^{[001]} = \sqrt{\varepsilon_{zz}^{\text{cr}}\mu}\boldsymbol{\kappa}$	$\mathbf{k}_{[010]}^{[100]} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\text{cr}}\mu}\kappa, \ \mathbf{k}_{[010]}^{[001]} = \sqrt{\varepsilon_{zz}^{\text{cr}}\mu}\kappa$	$\mathbf{k}_{[001]}^{[1\pm i0]} = \left(1 \pm \frac{B^0 \sqrt{c_{xxzz}^2 \kappa^2 - f_{xyz}^2}}{2\varepsilon_{xx}^{\mathrm{cr}}}\right) \sqrt{\varepsilon_{xx}^{\mathrm{cr}} \mu \kappa}$

Рис. 3. Таблица 1. (Цветная онлайн) Волновые векторы k для соответствующих направлений распространения света и магнитного поля \mathbf{B}^0 вдоль главных кристаллографических осей в парамагнитной фазе CuB_2O_4 . Нижний индекс при k отмечает направление распространения света, а верхний индекс обозначает вектор поляризации света \mathbf{E}^{ω} . Пять разных цветов обозначают пять различных возможных решений. Таблица приведена согласно статье [35] с разрешения American Physical Society



Рис. 4. Таблица 2. (Цветная онлайн) Волновые векторы k, соответствующие различным ориентациям магнитного поля \mathbf{B}^0 и направлениям распространения света в CuB₂O₄ в соразмерной фазе. Разными цветами отмечены пять различных решений. Таблица приведена согласно статье [35] с разрешения American Physical Society

ной дисперсии. Конкретный вид всех соответствующих тензоров диэлектрической проницаемости для CuB₂O₄ приведен в работе [35].

В табл. 1, приведенной на рис. 3, просуммированы результаты решений уравнений Максвелла для трех направлений волнового вектора **k** и магнитного поля \mathbf{B}^0 . Диагональные клетки в табл. 1 соответствуют геометрии Фарадея **k** || \mathbf{B}^0 , а недиагональные — геометрии Фохта **k** \perp \mathbf{B}^0 . Из таблицы видно, что в парамагнитной области, в дополнение к эффекту Фарадея, имеется \mathbf{kB}^0 -вклад магнитопространственной дисперсии, который разрешен в нецентросимметричных структурах. Сравнение выражений в клетках (1,1) и (2,2) показывает, что перестановка векторов **k** и \mathbf{B}^0 приводит к изменению знака вклада \mathbf{kB}^0 , что является следствием операции симметрии оси четвертого порядка с инверсией $\overline{4}$. Роль этой оси отражается также в том, что результаты оказываются различными при отклонении направления волнового вектора или магнитного поля от оси [100] к оси [010]. Решение в клетке (3, 3) интересно тем, что в этой фарадеевской геометрии при распространении света и направления поля вдоль оптической оси $\overline{4}$, когда отсутствует кристаллографическое двупреломление, вклад \mathbf{kB}^0 конкурирует с фарадеевским вкладом f_{ijk} (подкоренное выражение). Также следует отметить, что при изменении поляризации падающего света от [1 + i0] к [1 - i0] решение оказывается другим, т. е. ось $\overline{4}$ является, по сути, осью второго порядка. В соразмерной антиферромагнитной фазе (см. разд. 2.2.) выражение (1) должно быть дополнено членами, связанными с магнитными параметрами порядка, а именно, с ферромагнитным параметром

$$\mathbf{M} = \mathbf{S}_a + \mathbf{S}_b + \mathbf{S}_c + \mathbf{S}_d$$

и антиферромагнитным параметром

$$\mathbf{L} = \mathbf{S}_a - \mathbf{S}_b + \mathbf{S}_c - \mathbf{S}_d,$$

см. работу [17]. Развернутое разложение тензора диэлектрической проницаемости в соразмерной фазе приведено в статье [35]. Остановимся здесь только на результатах решений уравнений Максвелла, которые приведены в табл. 2 на рис. 4, где эффективный параметр $\mathbf{B} = \mathbf{B}^0(1 + \alpha)$ включает в себя внешнее магнитное поле \mathbf{B}^0 и ферромагнитный параметр порядка М, которые оба преобразуются одинаково. Введенный выше вектор L есть антиферромагнитный параметр магнитной структуры. Отметим, что в табл. 2 приведены результаты только для ориентации поля В в базисной плоскости (001). Всего в этом случае имеется пять решений, которые различны при ориентации поля В вдоль осей [110] или [110], что является следствием операции симметрии $\overline{4}$. В диагональных клетках (1,1) и (2,2) приведены решения, которые различаются при изменении направления вектора **k** от оси [100] к оси [010] несмотря на то, что обе эти оси перпендикулярны оптической оси [001]. При **k** || [001] (нижняя клетка) имеется два различных решения для поляризации света вдоль осей [110] и [110], соответственно.

4. ДИНАМИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ

4.1. Инфракрасная спектроскопия

Элементарная ячейка CuB_2O_4 с числом формульных единиц Z = 12 содержит 84 атома, но для анализа фононов можно рассмотреть примитивную ячейку с Z/2 = 6. Теоретико-групповой анализ дает следующий набор 126 решеточных мод в центре зоны Бриллюэна:

$$126 = 13A_1 + 17A_2 + 14B_1 + + 18B_2(T_z) + 32E(T_x, T_y).$$
(2)

Вычитание трех акустических мод $B_2(T_z) + E(T_x, T_y)$ оставляет 123 оптические колебательные моды, среди которых A_2 -моды являются темными (silent). Полярные моды $B_2(T_z)$ и $E(T_x, T_y)$



Рис. 5. (Цветной онлайн) Поляризованные ИК-спектры отражения монокристалла $\operatorname{CuB_2O_4}(a)$ для колебательных мод $B_2(z)$, когда электрический вектор света $\mathbf{E}(\omega)$ поляризован вдоль оси z, и (b) для мод E(x,y) при поляризации света вдоль оси x(y). Штриховые линии показывают сопоставление экспериментальных частот с первопринципными расчетными значениями в верхней части рисунков. Рисунок приведен согласно статье [3] с разрешения American Physical Society

являются активными в ИК-области спектра для поляризаций $E^{\omega} \parallel z$ и $E^{\omega} \parallel x$, соответственно. В CuB₂O₄ имеются четные неполярные моды $A_1(xx, yy, zz)$ и $B_1(xx, yy)$, где в скобках указаны поляризации электрического вектора падающего и рассеянного света, и нечетные полярные моды $B_2(T_z)$ и $E(T_x, T_y)$.

Динамика решетки CuB₂O₄ изучалась в статьях [3, 37, 38] и в некоторых других. Мы рассмотрим основные результаты работы [3], в которой изучались поляризованные ИК-спектры в геометрии отражения и пропускания в диапазоне от 20 до 2500 см⁻¹. Спектры характеризуются высоким спектральным разрешением отдельных линий, как это видно на рис. 5. Эти результаты позволили выделить все нормальные полярные колебательные моды $B_2(z)$ и E(x, y) в полном соответствии с симмет-



Рис. 6. (Цветной онлайн) Поляризованные спектры комбинационного рассеяния света CuB_2O_4 для полносимметричных $A_1(zz)$ мод (слева) и для $(A_1 + B_1)$ мод (справа). Вертикальные линии в нижней части рисунков показывают расчетные значения частот и их сопоставление с соответствующими экспериментальными частотами. Рисунки приведены согласно статье [3] с разрешения American Physical Society

рийным анализом. Частоты поперечных (ТО) и продольных (LO) оптических полярных фононов были определены из аппроксимации ИК-спектров отражения с использованием модели диэлектрической проницаемости в виде суммы затухающих осцилляторов Лоренца. Численные значения всех идентифицированных частот в виде таблиц приведены в статье [3]. Весь спектральный диапазон, в котором наблюдались колебательные моды, можно условно разбить на три области. В низкочастотной и высокочастотной областях имеется высокая плотность фононов, а в средне-частотной области фононов много меньше, и лишь выделяется интенсивный полярный $B_2(z)$ фонон в поляризации $E^{\omega} \parallel z$ при частоте $\omega_{\rm TO} = 694 \, {\rm cm}^{-1}$ и $\omega_{\rm LO} = 703 \, {\rm cm}^{-1}$. Следует еще добавить, что несколько дополнительных слабых линий в спектрах пропускания наблюдались в диапазоне $1200 - 2500 \text{ см}^{-1}$, но их симметрийный анализ не проводился. Эти линии были отнесены к многофононным процессам [3].

4.2. Комбинационное рассеяние света

Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) были изучены в геометрии отражения, что позволило определить частоты большинства четных неполярных мод $A_1(xx, yy, zz)$ и $B_1(xx, yy)$, где в скобках указаны поляризации электрического вектора падающего и рассеянного света. Характерные спектры для $A_1(zz)$ и $(A_1 \, \text{ и } B_1)$ КРС-мод показаны на рис. 6. Аналогичные исследования были проведены для нечетных полярных продольных LO мод $B_2(z)$ и E(x, y). Анализ результатов

позволил высказать предположение, что несколько групп близко расположенных спектральных линий в колебательных КРС-спектрах CuB_2O_4 можно трактовать как результат давыдовского расщепления, которое должно иметь место при наличии в элементарной ячейке нескольких эквивалентных молекулярных единиц [39]. Следует добавить, что роль давыдовского расщепления проявляется не только в спектрах фононов, но даже более ярко в структуре электронных спектров, что будет рассмотрено в разд. 5.4.

В низкочастотной области в спектрах КРС при низких температурах наблюдалась особенность с центром при 82 см⁻¹, которая была приписана двухмагнонному рассеянию [37]. Предложенная в этой работе теоретическая модель дисперсии магнонов в соразмерной фазе CuB₂O₄ позволила сделать оценку обменного интеграла величиной J = 33 см⁻¹ между ближайшими ионами в 4*b*-подсистеме.

Теоретические расчеты всех полярных и неполярных колебательных мод в центре зоны Бриллюэна для CuB₂O₄ были выполнены с использованием теории функционала плотности (DFT) [3]. Расчеты позволили достичь хорошего согласия между вычисленными частотами всех фононных мод с наблюдаемыми положениями линий в ИК- и КРСспектрах и предложить обоснованную идентификацию всех фононных мод в центре зоны Бриллюэна. Сопоставление экспериментальных и расчетных результатов для ИК- и КРС-спектров показано на рис. 5 и 6.



Рис. 7. (Цветной онлайн) Сопоставление экспериментальных нормированных спектров спонтанного (a, b, c) [3] и стимулированного (d, e, f) [41] КРС в CuB₂O₄. Символами показаны экспериментальные результаты; линии показывают их аппроксимацию с использованием функций Лоренца. Цифры разных цветов обозначают частоты фононных мод с симметрией A_1 (черный), B_1 (красный) и E(y) (синий). Зеленым цветом обозначены фононы обеих, A_1 и B_1 , симметрий. На вставке показаны зависимости амплитуд нескольких мод от плотности потока накачки, которые подчиняются линейным зависимостям. Рисунки приведены согласно статьям [3,41] с разрешения American Physical Society

Недавно при изучении спектров фононов в CuB_2O_4 при высоких давлениях было установлено, что кристаллическая структура может претерпевать изменения, и это заключение было сделано на основании некоторых изменений в спектрах [40]. Несмотря на эти изменения, в рентгеновских дифракционных (XRD) картинах не было обнаружено никаких особенностей, которые можно было бы трактовать как изменения кристаллической структуры. Поэтому можно полагать, что на сегодняшний день вопрос о структурном фазовом переходе в CuB_2O_4 при изменении давления пока остается открытым.

4.3. Возбуждение когерентных фононов

Как развитие изложенных выше исследований термически возбуждаемых некогерентных четных фононов, недавно было сообщено об импульсном возбуждении в CuB_2O_4 нескольких когерентных фононных мод [41]. Это исследование позволило провести сравнение между двумя наборами результатов изучения когерентной и некогерентной фононной динамики. Исследование когерентных фоимпульсной накачки, которая позволяет реализовать процесс вынужденного, или стимулированного, комбинационного рассеяния. Этот метод получил в литературе название импульсного стимулированного комбинационного рассеяния (Impulsive Stimulated Raman Scattering, ISRS) [42], и в настоящее время он широко используется для изучения не только фононов, но и магнонов. Импульсная поляризованная лазерная накачка может возбуждать в кристалле когерентные фононы разной симметрии, что приводит к соответствующему понижению симметрии кристалла и наведению в нем короткоживущего оптического линейного двупреломления. Это короткоживущее понижение симметрии можно зарегистрировать поляриметрическими методами, как это использовалось при исследованиях линейного двупреломления, создаваемого при магнитном упорядочении или в приложенном к образцу магнитном поле [43, 44].

нонов было проведено с использованием лазерной

Из рис. 7 видно, что для спектров спонтанного некогерентного и стимулированного когерентного рассеяния можно отметить совпадения по частотам отдельных фононных мод в диапазоне от 4 до 12 ТГц. Длительности импульсов накачки в 90 фс и зондирования в 50 фс в экспериментах по импульсному стимулированному рассеянию ограничивают максимальную частоту возбуждаемых и регистрируемых когерентных фононных мод до 12 ТГц. Кроме того, длительность импульсов накачки и зондирования определяют относительные амплитуды регистрируемых мод. Эти факторы объясняют многие различия между результатами по когерентной и спонтанной фононной динамике, поскольку во втором методе используется значительно менее интенсивная и, как правило, непрерывная лазерная накачка. Еще следует отметить хорошо выраженную асимметричность фононных откликов в стимулированных спектрах, что может служить свидетельством резонанса Фано, наблюдаемого при интерференции между узкими резонансными модами и широким нерезонансным спектральным фоном [45]. Наиболее сильно резонанс Фано проявляется на интенсивной линии при 10 ТГц. На настоящий момент роль резонанса Фано в наблюдаемой асимметрии фононных откликов остается не исследованной ни экспериментально, ни теоретически.

5. ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ИОНОВ Cu²⁺

5.1. Расщепление электронных уровней иона Cu²⁺

Свободный ион меди Cu²⁺ имеет внешнюю вырожденную электронную оболочку $3d^9$, вырождение которой снимается в кристалле в соответствии с симметрией локального кристаллического поля [48]. В метаборате меди это поле создается ближайшими кислородными анионами О²⁻ в двух 4b- и 8dпозициях иона Cu²⁺, в которых симметрия и сила локального кристаллического поля различны. На рис. 8 приведена схема расщепления уровней для этих двух позиций, построенная на основе экспериментальных спектров оптического поглощения (разд. 5.2.). Схема уровней $3d^9$ -орбиталей иона Cu²⁺ приведена в дырочном представлении. В левой части диаграммы показано расщепление уровней иона Cu^{2+} в позиции 4b (симметрия $\overline{4}$), в которой (xz)и (уг)-состояния остаются вырожденными. В правой части показана схема состояний иона Cu²⁺ для 8d-позиции с более низкой симметрией (ось второго порядка 2), в которых реализуется полное расщепление на пять состояний.



Рис. 8. (Цветной онлайн) Одноэлектронная схема расщепления $3d^9$ -орбиталей иона Cu²⁺ в приближении кристаллического поля в 4b- (слева) и 8d- (справа) подсистемах в дырочном представлении. Цифры обозначают положения уровней в эВ относительно основного состояния $(x^2 - y^2)$. Схема отличается от ранее приведенной в статьях [46, 47] перестановкой z^2 - и (yz, xz)-уровней в соответствии со схемой в монографии [48]. Экситонное представление этой схемы уровней она Cu²⁺ рассмотрено в разд. 5.4

5.2. Поглощение в области переходов между 3d⁹-состояниями

Поляризованные спектры поглощения CuB₂O₄ при низких температурах характеризуются исключительно насыщенной тонкой структурой в спектральном диапазоне 1.4-2.4 эВ, как показано на рис 9. Такой насыщенный спектр можно назвать уникальным, поскольку подобной структуры спектра поглощения во всем диапазоне $3d^9$ -переходов не наблюдалось ни только в другом известном борате меди Cu₃B₂O₆ [15], но, насколько нам известно, ни в каком-либо другом магнитоупорядоченном 3dⁿ-кристалле. Тем не менее, анализ показывает, что в этом сложном наборе линий можно выделить шесть наиболее узких линий, которые можно приписать к бесфононным (БФ) электронным переходам [49] в ионах Cu^{2+} в обеих 4b- и 8d-позициях в соответствии с рис. 8.

Синие узкие линии поглощения в приведенном спектре соответствуют БФ-линиям, наблюдаемым в α - и σ -спектрах, а красные узкие БФ-линии наблюдаются во всех трех типах спектров, что служит важным основанием для отнесения всех этих шести линий к той или другой позиции. Каждая БФ-линия имеет многочисленные фононные спутники, или сателлиты, число которых для некоторых переходов насчитывает более полусотни. Некоторые из этих сателлитов можно сопоставить с частотами фононов в ИК- и КРС-спектрах, приведенных в разд. 4.



Рис. 9. (Цветной онлайн) Спектры поглощения CuB₂O₄ при T = 5 К в диапазоне электронных переходов между всеми $3d^9$ -состояниями иона Cu²⁺ в кристаллическом поле. Спектры приведены для трех различных ориентаций направления распространения k и поляризации электрического поля света \mathbf{E}^{ω} по отношению к кристаллографическим осям x, y и z. Сверху вниз: α -спектр ($\mathbf{k} \parallel z, \mathbf{E} \parallel x$); σ -спектр ($\mathbf{k} \parallel y, \mathbf{E} \parallel x$); π -спектр ($\mathbf{k} \parallel y, \mathbf{E} \parallel z$). Рисунок приведен согласно статье [47] с разрешения American Physical Society

Наблюдение трех возможных типов поляризованных спектров в одноосном кристалле CuB₂O₄ позволяет выделить вовлеченность в каждый из них конкретных вкладов от электродипольных (ЭД) и магнитодипольных (МД) переходов [50], и такой анализ говорит о существенном различии между 4b- и 8d-подсистемами. Между α- и σ-спектрами наблюдается хорошее совпадение по частотам БФлиний и фононных сателлитов, но лишь частичное совпадение по интенсивностям, что свидетельствует о вкладе в наблюдаемое поглощение как ЭД-, так и МД-переходов. Для переходов в 4b-подсистеме ионов Cu²⁺ доминирует ЭД-механизм, а вклад МДмеханизма находится на уровне нескольких процентов. Это хорошо проявляется для первого БФперехода и его фононных сателлитов в области 1.405–1.57 эВ, интенсивность которых в π -спектре очень слабая, на уровне единиц процентов и меньше. Для БФ-линии это более подробно обсуждается в разд. 5.4. Совсем другое поведение наблюдается для всех трех переходов в 8d-подсистеме, как это видно на рис. 8. Линии поглощения в этой подсистеме присутствуют с существенным вкладом во всех трех поляризациях, но в π -спектре их интенсивность не подавляется, что наблюдается в 4bподсистеме, но даже становится больше, чем в α и σ -спектрах (см. рис. 9). Такое поведение есть явное свидетельство того, в 8*d*-подсистеме доминирует МД-вклад. Существенное различие между 4b- и 8dподсистемами также хорошо проявляется в температурном поведении БФ-линий. При повышении температуры линии 4b-подсистемы уширяются и быстро исчезают выше T_N [4]. Напротив, БФ-линии 8dподсистемы наблюдаются при температурах в районе 150 К, т.е. значительно выше T_N . Здесь следует напомнить, что существенно различное поведение двух подсистем наблюдается в их магнитных свойствах, когда 4b-подсистема упорядочивается при T_N , а 8*d*-подсистема остается лишь частично упорядоченной вплоть до самых низких температур [17].

Надежная идентификация всех шести БФ-линий в оптическом спектре CuB_2O_4 позволила сделать оценку параметров кристаллического поля для $3d^9$ -состояний иона Cu^{2+} в двух различных подсистемах. Можно предположить, что локальная симметрия иона Cu^{2+} в обеих позициях является приблизительно тетрагональной, и тогда положение уровней (рис. 8) определяется кубическим параметром Dq и тетрагональными параметрами Ds и Dt [48]. Естественно, что параметры должны быть различны для двух позиций, поскольку длины связей Cu–O в них различаются [2]. С использованием последовательность уровней на рис. 8, были получены следующие значения параметров кристаллического поля в единицах эВ:

для 4b-ионов
$$Cu^{2+}$$
:
 $10Dq = 1.405(1.405), Ds = 0.311(0.331),$
 $Dt = 0.084(0.134);$
для 8d-ионов Cu^{2+} :
 $10Dq = 1.577(1.577), Ds = 0.345(0.345),$
 $Dt = 0.099(0.148).$

В скобках приведены значения Ds и Dt для последовательности уровней, когда состояние z^2 выше по энергии, чем состояние (xz, yz), как это предполагалось в [47]. Существенное различие между двумя моделями наблюдается только для параметров Dt. Вопрос о том, какая из этих двух моде-



Рис. 10. (Цветной онлайн) (a, b) σ -спектры поглощения CuB₂O₄ в соразмерной фазе при T = 10 K в геометрии Фохта $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$. Поле $\mathbf{B} = \pm 0.2$ Tл направлено вдоль оси c (001) кристалла, $\mathbf{B} \parallel c$. (c) Невзаимность как разность коэффициентов поглощения для противоположных направлений поля. (d) Невзаимность в области первого перехода в увеличенном масштабе. Рисунки приведены согласно статье [4] с разрешения MDPI

лей более адекватна, может быть решен в экспериментах с более высоким спектральным разрешением, как это было исследовано на первом переходом (см. разд. 5.4.). С использованием полученных параметров в качестве контрольных значений, была проведена оценка параметров Dq, Ds и Dt в рамках модели кристаллического поля для некоторых других купратов с различной длиной связи Cu–O. В частности, был проведен анализ расщепления $3d^9$ -уровней в La₂CuO₄, Nd₂CuO₄, CuGeO₃, Sr₂CuO₂Cl₂ и Cu₃B₇O₁₃Cl [47].

Электронные переходы между $3d^9$ -состояниями иона Cu²⁺ с фононными повторениями занимают спектральную область приблизительно до 2.4 эВ. Выше по энергии имеется окно прозрачности в диапазоне 2.4–4.0 эВ, которое определяет голубой цвет монокристаллов CuB₂O₄ [47]. Край оптический поглощения был недавно исследован с использованием спектроскопической эллипсометрии [51]. В статье сообщается, что край поглощения можно трактовать как следствие прямого перехода с переносом электрона из 2*p*-состояний ионов кислорода в $3d^9$ -состояния ионов меди при энергии ~ 3.88 эВ. В структуре края поглощения оказалось возможным выделить две интенсивные полосы поглощения около 4.49 и 5.90 эВ.

5.3. Невзаимность оптического поглощения

В разд. 3.2. был проведен общий симметрийный анализ взаимного и невзаимного распространения и поглощения света в CuB₂O₄ на основе решений уравнений Максвелла без учета конкретной электронной структуры иона Cu²⁺, а только с учетом симметрии кристаллической и магнитной структур. Спектральные проявления невзаимности в CuB₂O₄ в области электронных переходов рассматривались в работах [4, 52, 53]. В этом разделе мы рассмотрим результаты экспериментального исследования невзаимности по работе [4]. Поглощение изучалось в широком спектральном интервале, включающем все $3d^9$ -электронные переходы в обеих 4b- и 8dподсистемах иона Cu²⁺. Теоретический анализ был проведен для первого экситонного перехода в 4bподсистеме в районе 1.405 эВ.

Общий вид спектра поглощения в соразмерной фазе при T = 10 К в широкой спектральной области приведен на рис. 10. Спектр показан в области, включающей все электронные переходы в обеих 4b- и 8d-подсистемах (кроме 8d-перехода при 2.12 эВ). Направления распространения света, ориентация поляризации и направления магнитного поля указаны на вставках. Оптическая невзаимность, или в данном случае разность коэффициентов по-

глощения для противоположных направлений поля, показана на рис. 10(с). Сначала следует отметить, что спектральная зависимость характеризуется широким нерезонансным фоном во всей области со сменой знака вблизи ~ 1.7 эВ, и на этом фоне хорошо проявляются узкие резонансные особенности в области экситонных переходов в обеих 4b- и 8dподсистемах. Особо можно отметить «гигантскую» невзаимность в области первого экситонного перехода в 4b-подсистеме в районе 1.405 эВ, достигающую более 60%. Из рис. 10(d) видно, что этот переход также имеет сателлит с большой невзаимностью противоположного знака на уровне 40% при более высокой энергии, который приписывается магнону [4]. Для других БФ-переходов структура невзаимности носит сложный знакопеременный характер, что требует дальнейшего экспериментального и теоретического исследования.

Подробный теоретический анализ оптического поглощения и невзаимности был проведен для первого экситона в области 1.405 эВ [4]. Анализ показал, что основным механизмом возникновения невзаимности является интерференция между ЭДи МД-вкладами в экситонное поглощение. В заключении этого раздела можно сказать, что наблюдение в борате меди БФ-линий поглощения на всех электронных переходах в обеих 4b- и 8d-подсистемах иона Cu^{2+} открывает уникальные возможности для проведения детальных экспериментальных исследований поглощения с использованием спектроскопии высокого разрешения, и на основе этих результатов могут быть разработаны теоретические модели невзаимности для всех экситонных переходов, в том числе в различных коллинеарных и более сложных неколлинеарных магнитных фазах CuB₂O₄ (см. рис. 2).

5.4. Экситоны Френкеля

В этом разделе рассматриваются результаты исследования оптического поглощения в CuB_2O_4 во внешнем магнитном поле с использованием аппаратуры с высоким спектральным разрешением. Эти исследования показали, что одноэлектронная модель структуры $3d^9$ -состояний в кристаллическом поле (разд. 5.2.) явно не достаточна для описания тонкой структуры линий поглощения и их расщепления в магнитном поле.

Теория кристаллического поля находит широкое применение и позволяет дать обоснованное объяснение спектров в тех случаях, когда $3d^n$ -ионы находятся в кристалле в виде примесей, взаимодействием



Рис. 11. (Цветной онлайн) Поляризованные α -спектры (а) и π -спектры (b) поглощения $\operatorname{CuB}_2\operatorname{O}_4$ при T = 1.6 К в нулевом внешнем магнитном поле в области перехода из основного $(x^2 - y^2)$ в первое возбужденное (xy) состояние ионов Cu^{2+} в 4*b*-позициях. Закрашенные зеленым и синим цветом области соответствуют гауссовой форме линий, их полуширины обозначены как $W_{A(B)}$. Дублетное расщепление, отнесенное к возбужденному состоянию, обозначено как $\Delta \zeta$. Рисунки приведены согласно статье [60] с разрешения American Physical Society

между которыми можно пренебречь [48]. Эта теория также оказывается правомерной, когда линии поглощения уширены из-за сильной ковалентности связей между эквивалентными магнитными ионами в элементарной ячейке, и следовательно, тонкая структура оказывается скрытой в ширине линий поглощения. Тонкая структура спектров характерна для фторидных $3d^n$ -антиферромагнетиков, когда взаимодействие между магнитными ионами носит преимущественно ионный характер, и некоторых оксидных антиферромагнетиков. Вопросы тонкой структуры спектров магнитных диэлектриков, их строгой интерпретации и проявляющегося в некоторых случаях давыдовского расщепления в рамках



Рис. 12. (Цветной онлайн) Сдвиги и расщепления π -линий поглощения образца (101) при T = 1.6 К в области оптических переходов между основным ($x^2 - y^2$) и первым возбужденным состоянием (xy) в 4b-подсистеме ионов Cu²⁺. Результаты на панелях (b) и (c) получены в конфигурации $\mathbf{B} \parallel c(z)$; на панелях (e) и (f) в конфигурации $\mathbf{B} \parallel a(x)$. Сплошные линии на панелях (c) и (f) показывают результаты расчетов экситонных состояний Френкеля в магнитном поле, выполненных на основе разработанной теории [60]. Рисунки приведены согласно статье [60] с разрешения American Physical Society

экситонной модели рассматривались в ряде оригинальных и обзорных статей [54–59]. В этих работах обсуждались по большей части материалы на основе ионов Mn^{2+} и Cr^{3+} , но ион Cu^{2+} , насколько нам известно, ни в этих, ни в других работах не фигурировал.

Экспериментальное исследование тонкой структуры спектров поглощения в CuB₂O₄ было проведено в области первого электронного перехода вблизи 1.405 эВ в 4b-подсистеме иона Cu^{2+} [60], и в этой же статье была предложена микроскопическая теория в рамках экситонной модели. Диаграмма на рис. 8 показывает, что в одноэлектронном приближении поглощение определяется оптическим переходом между двумя синглетными (x^2-y^2) - и (xy)-состояниями, и следовательно, в приближении теории кристаллического поля линия поглощения должна быть синглетной. Однако измерения в области этого перехода с высоким спектральным разрешением показали, что линия поглощения имеет дублетную структуру (рис. 11). Дублетная структура этой линии поглощения ранее отмечалась в статье [61] и предположительно была объяснена как результат давыдовского расщепления в модели примитивной ячейки (Z/2 = 6), содержащей два 4b иона Cu²⁺. Теоретикогрупповой анализ экситонов в CuB₂O₄ в центре зоны Бриллюэна также в модели примитивной ячейки был проведен в работе [62].

Исследования поляризованных спектров поглощения были проведены для *а*-конфигурации при $\mathbf{k} \parallel c(z)$ и $\mathbf{E}^{\omega} \parallel a(x)$ на образце с ориентацией (001), т.е. при распространении света вдоль оптической оси (рис. 11 (a)). Измерения π -спектров в геометрии $\mathbf{k} \parallel b(y)$ и $\mathbf{E}^{\omega} \parallel c(z)$ проводились на образце с ориентацией (101) (рис. 11 (b)). Коэффициенты поглощения в соответствующих спектрах различаются более чем на порядок, как отмечено на этом рисунке. Согласно правилам отбора, α-спектры отражают ЭДпереходы, а π -спектры — МД-переходы [50, 60]. Наблюдаемое дублетное расщепление БФ-линии представляется неожиданным в одноэлектронной модели кристаллического поля, поскольку эта линия соответствует оптическому переходу между двумя невырожденными состояниями иона Cu²⁺, и следовательно, в нулевом магнитном поле линия поглощения должна быть синглетной. В большинстве магнитоупорядоченных кристаллов бесфононные линии поглощения широкие, или даже они вообще отсутствуют, и поэтому взаимодействие между эквивалентными ионами в элементарной ячейке не проявляется. Если же БФ-линии поглощении достаточно узкие, то тогда при интерпретации спектров необходимо учитывать взаимодействие между эквивалентными ионами в элементарной ячейке кристалла, которое может найти проявление в виде давыдовского расщепления [39].

Исследование было проведено на переходе между основным и первым возбужденным состоянием в районе 1.4056 – 1.4062 эВ в магнитном поле *В* вдоль главных кристаллографических осей a(x) и c(z), и результаты показаны на рис. 12. Здесь панели (b) и (е) представляют собой контурные рисунки, где интенсивность поглощения кодируется разными цветами. Экспериментальные зависимости максимумов линий поглощения от магнитного поля как следствие эффекта Зеемана показаны символами на панелях (b) и (e). Контурные рисунки наглядно показывают, что картина расщепления в слабых полях размыта и позволяет говорить только о наличии двух линий поглощения, как это также видно на рис. 11. Размытость линий в слабых полях можно связать с существованием различных магнитных фаз в соответствии с магнитной фазовой диаграммой на рис. 2 [18]. В магнитном поле больше $B \sim 1.4$ Тл происходит резкое изменение спектра и наблюдается четкое расщепление дублета на восемь линий. Этот результат ставит важный вопрос — почему при наличии в элементарной ячейке четырех ионов Cu²⁺ в 4*b*-позиции наблюдается восемь линий в зеемановских спектрах? Сам по себе экспериментальный результат не может дать ответ на этот вопрос.

Ответ на вопрос о числе линий и их расщеплении для перехода в области 1.4056–1.4062 эВ был получен в результате микроскопического теоретического анализа в модели экситонов Френкеля [63], связанных с основным и первым возбужденным состоянием 4b-ионов Cu²⁺. В рамках этой модели количество экситонов определяется наличием четырех ионов Cu²⁺ в элементарной ячейке с дважды вырожденным спиновым состоянием S = 1/2 иона $3d^9$ [60]. Теоретический анализ показал, что энергии френкелевских экситонов определяются обменным взаимодействием ионов Cu²⁺ величиной ~ 0.5 мэВ (~ 4 см⁻¹) в возбужденном (*xy*)-состоянии с окружающими ионами Cu²⁺. Для учета такого взаимодействия необходимо сделать переход от модели кристаллического поля, рассмотренной в разд. 5.2, к экситонной модели. Давыдовское расщепление величиной 0.12 мэВ (~ 1 см⁻¹) имеет место уже в нулевом магнитном поле (рис. 11), и его величина не зависит от поля для всех четырех зеемановских групп линий (рис. 12). Таким образом, трактовка БФ-линий поглощения в спектрах поглощения CuB_2O_4 и их поведение в магнитном поле получают обоснованное объяснение при рассмотрении этих линий как френкелевских экситонов. Представляет большой интерес проведение экспериментов и разработка теоретических моделей для других экситонных переходов в обеих 4b- и 8d-подсистемах ионов Cu^{2+} .

6. ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Фотолюминесценция (ФЛ) в магнитоупорядоченных кристаллах является очень редким явлением по причине так называемого концентрационного гашения, и поэтому сравнительно сильная ФЛ наблюдалась фактически лишь в единичных случаях. Эффект подавления ФЛ в диэлектриках при 100%концентрации магнитных ионов наиболее сильно проявляется для $3d^n$ -ионов переходных металлов изза сильного межионного взаимодействия, когда имеет место эффективная передача оптического возбуждения между одинаковыми центрами. Хорошим примером такого подавления является магнитный $3d^3$ -ион Cr^{3+} в рубине, т.е. в кристалле сапфира Al₂O₃, где этот ион выступает в роли примеси. При малых концентрациях Cr³⁺ ФЛ настолько сильная, что это позволило впервые получить на этих кристаллах лазерную генерацию [64]. Но при 100%-концентрации ионов Cr³⁺ в изоструктурном антиферромагнетике Cr₂O₃ люминесценция крайне слабая [65].

Анализ ФЛ в магнитоупорядоченных кристаллах проводился в нескольких обзорах [56–59, 65, 66]. Взаимодействие между магнитными ионами приводит к тому, что поглощение и ФЛ происходит не за счет одиночных изолированных друг от друга примесных ионов в кристаллах с их малой концентрацией, а определяются взаимодействием света со всем ансамблем эквивалентных ионов. В этом случае соответствующие коллективизированные электронные состояния следует рассматривать как экситоны, которые характеризуются волновым вектором \mathbf{k} [36, 39, 58]. Исследования ФЛ в магнитоупорядоченных материалах немногочисленны по причине того, что ФЛ наблюдалась лишь в немногих



Рис. 13. (Цветной онлайн) Спектр ФЛ (слева, черная линия) и σ -спектр поглощения (справа, красная линия) в CuB₂O₄ в геометрии $\mathbf{k} \perp c$, $\mathbf{E}^{\omega} \perp c$ в диапазоне энергий оптического перехода ниже 1.405 эВ в 4*b*-подсистеме при T = 5 К. Рисунок приведен согласно статье [68] с разрешения American Physical Society

материалах, и некоторые примеры были рассмотрены в приведенных выше обзорах и монографиях. Еще следует добавить, что возможна как собственная (intrinsic) экситонная ФЛ, так и ФЛ, обусловленная локализованными состояниями, которые могут наблюдаться в антиферромагнитных диэлектриках, легированных примесными ионами [67].

Насколько нам известно, среди этих работ не было никаких сообщений о наблюдении ФЛ в магнитоупорядоченных кристаллах на основе иона Cu^{2+} , и поэтому обнаружение интенсивной ФЛ в CuB₂O₄ в широком спектральном диапазоне было достаточно неожиданным [52, 68, 69]. В этом разделе мы рассмотрим некоторые результаты по ФЛ в CuB₂O₄, полученные с использованием аппаратуры с высоким спектральным разрешением [68]. Спектр ФЛ возбуждался при фотонной энергии E_{exc} = 1.45 эВ, т.е. выше первого экситонного перехода в 4b-подсистеме ионов Cu²⁺ в области 1.4052 эВ. Отметим, что при выборе такой энергии возбуждения реализуется селективная накачка только 4b-подсистемы (см. спектр поглощения на рис. 8, 9). Стрелки и цифры на рис. 13 отмечают положение бесфононной линии поглощения для перехода между основным состоянием $(x^2 - y^2)$ и первым возбужденным состоянием (xy) (рис. 8). Линия X_2 (1.3935 эВ) в ФЛ соответствует экситонному переходу в спектре поглощения (1.4052 эВ). Разность энергии между линиями X₂ и M₂ соответствует энергии магнона. Показанный справа на рис. 13 спектр поглощения начинается с БФ-линии, обсуждавшейся выше в разд. 5.2. Интенсивная ФЛ наблюдалась только в области первой по энергии линии поглощения, и на рис. 13 показан соответствующий спектр при T = 5 К. Сопоставление этих двух спек-



Рис. 14. (Цветной онлайн) Температурные зависимости спектров ФЛ в широком спектральном диапазоне при нескольких температурах от 1.7 до 25 К. При низкой температуре спектры характеризуются богатой структурой, но при повышении температуры структура становится более простой. Рисунок приведен согласно статье [68] с разрешения American Physical Society

тров с учетом их зеркального отражения друг от друга свидетельствует об большом различии между ними. В спектре поглощения БФ-линия сопровождается богатой структурой фононных сателлитов (см. также рис. 9), но в спектре ФЛ картина совсем другая, что рассматривается ниже.

Спектры ФЛ в виде множества отчетливых линий различной формы и интенсивности были зарегистрированы в диапазоне от 1.4052 до 1.3 эВ, а при более низких энергиях наблюдалась широкая бесструктурная полоса ФЛ вплоть до 1.2 эВ. В диапазоне от 1.4052 до 1.36 эВ спектры ФЛ приведены на рис. 14, из которого видно, что изменение температуры от 1.7 до 25 К приводит к радикальным перестройкам спектров. Наиболее богатая структура наблюдается при T = 1.7 К, которую можно связать



Рис. 15. Карта температурных изменений ФЛ в спектральном диапазоне от экситонной линии X_1 в спектре поглощения при 1.4052 эВ до экситон-магнонной пары X_3 (1.374 эВ) – M_3 (1.367 эВ), интенсивность которой растет в диапазоне T = 10-20 К. Рисунок приведен согласно статье [68] с разрешения American Physical Society

с эмиссией от различных локализованных состояний, связанных с ионом Cu²⁺. Эмиссия начинается со слабой линии при 1.4052 эВ, соответствующей БФ-линии в спектре поглощения ($U_{\rm abs}^{\rm PL}$). На рис. 14 стрелками X_i помечены линии, которые можно связать с ФЛ локализованных экситонов, а стрелки М_i отмечают положения соответствующих локализованных магнонов. Стрелками U_i помечены линии, которые можно приписать локализованным фононам. Уже при T = 7 К спектр $\Phi \Pi$ становится более простым и происходит перераспределение относительных интенсивностей между отдельными линиями. Дальнейшее повышение температуры приводит к исчезновению некоторых линий в спектрах, но даже при T = 15 К хорошо различимы группы линий $X_2 - M_2$ и $X_3 - M_3$, связанные с экситон-магнонными парами.

Температурные изменения интенсивностей и положения различных локализованных состояний в спектре ФЛ наглядно показаны на рис. 15 в виде контурной карты. При повышении температуры хорошо прослеживается удлинение времени жизни различных экситон-магнонных пар. Пара $X_1 - M_1$, соответствующая не примесной, а собственной люминесценции, сохраняется лишь при очень низких температурах и быстро исчезает около T = 5 K. Пара $X_2 - M_2$ наблюдается вплоть до температуры $T_N = 21$ K, а наиболее интенсивная пара $X_3 - M_3$ сохраняется даже при T = 25 K, т.е. заметно выше T_N , а возможно, сохраняется и при еще более высокой температуре. Такое поведение глубоких экситон-магнонных пар можно трактовать как удлинение их времени жизни при удалении от экситонной линии поглощения при 1.4052 эВ.

Эти исследования Φ Л в CuB₂O₄ с высоким спектральным разрешением в температурном интервале от 1.7 до 25 К позволили построить энергетическую диаграмму нескольких связанных экситонмагнонных состояний локальных центров вокруг магнитного иона Cu²⁺ (см. рис. 15 в статье [68]). Важным обоснованием для построения такой диаграммы было изучения временных зависимостей релаксации этих состояний в диапазоне от единиц микросекунд в мелких локальных центрах до сотен наносекунд в глубоких центрах, и многие детали этих исследований подробно рассмотрены в статье [68].

7. ВТОРАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИКА

В предыдущих разделах рассматривались результаты по линейным по интенсивности процессам взаимодействия света с CuB₂O₄. В этом разделе будут обсуждаться нелинейные процессы, а именно генерация второй оптической гармоники (ГВГ). ГВГ представляет собой нелинейно-оптический когерентный процесс, в котором фотоны лазерной импульсной накачки в результате взаимодействия с нелинейным материалом образуют новые фотоны с удвоенной частотой, и следовательно, с удвоенной энергией [71,72]. Наибольший интерес для изучения и практического использования ГВГ представляют кристаллы или структуры без центра инверсии, так как в них этот процесс разрешен в ЭД-приближении. Для практических применений в первую очередь интерес представляют оптическипрозрачные кристаллы и структуры, когда нет поглощения ни на частоте накачки, ни на частоте ВГ, т.е. процесс ГВГ является нерезонансным. Напротив, для исследований электронных и магнитных структур различных материалов с использованием ГВГ наибольший интерес представляют резонансные процессы, когда или частота накачки, или частота ГВГ, или даже обе вместе, находятся в резонансе с электронными (экситонными) возбуждениями [73–77]. Резонансные процессы ГВГ в большинстве случаев являются более эффективными, чем не резонансные.

Кристаллическая структура CuB_2O_4 не имеет центра инверсии (точечная группа $\overline{43m}$), что в первую очередь снимает запрет с наиболее сильных оптических ЭД-процессов. ЭД-механизм открывает интересные возможности для резонансных проявлений ГВГ на очень богатой структуре экситонных, экситон-магнонных и экситон-фононных линий в спектрах поглощения в обеих 4b- и 8d-подсистемах иона Cu²⁺ (см. рис. 8). Но наряду с этим процесс ГВГ возможен в МД- и квадрупольном (КП) приближениях [71, 72]. Хотя два последних механизма, как правило, менее эффективны в сравнении с ЭД-механизмом, тем не менее они могут реализоваться в тех случаях, когда ЭД-механизм ослаблен или запрещен по соображениям симметрии, в то время как МД- и КП-механизмы могут быть разрешены [73–77]. Конечно, возможны случаи, когда несколько механизмов разрешены одновременно и могут интерферировать между собой, и некоторые примеры будут рассмотрены ниже.

На рис. 16 схематично показан процесс ГВГ в случае экситонного перехода между основным и первым возбужденным состоянием 4b-иона Cu²⁺ в CuB₂O₄. В работах [46,74] метод ГВГ был применен для установления корреляций между резонансным оптическим поглощением на экситонных переходах и спектрами ГВГ, а также для изучения магнитной фазовой диаграммы CuB₂O₄. Важным результатом этих исследований было то, что фазовая диаграмма сильно изменяется в магнитном поле, причем поразному при ориентации магнитного поля величиной до B = 7 Тл вдоль основных кристаллографических направлений. Впоследствии магнитная фа-



Рис. 16. (Цветной онлайн) Схематическая диаграмма когерентных процессов ГВГ на оптическом переходе между основным и возбужденным состоянием 4b ионов Cu²⁺, когда два $\hbar\omega$ фотона накачки преобразуются в одиночный фотон излучения с частотой $2\hbar\omega$. Вертикальные стрелки обозначают кристаллический *С*-механизм и В-механизм, наводимый магнитным полем. Стрелка $\mathbf{T} \parallel \mathbf{L}$ обозначает тороидно-антиферромагнитный $\mathbf{T} - \mathbf{L}$ механизм ГВГ, который может реализоваться в CuB₂O₄. Знаки \pm показывают возможность синфазной и противофазной интерференции между разными механизмами, соответственно. Рисунок приведен согласно статье [70] с разрешения American Physical Society

зовая диаграмма изучалась в нескольких работах, и ссылки на многие из них приведены в статье [18], в которой подробно была изучена эта диаграмма. Исследования ГВГ в работах [46,74] были выполнены с использованием 5 нс лазерных импульсов. Последующее применение фемтосекундных методик для исследований резонансных проявлений ГВГ позволило значительно расширить возможности метода для изучения электронных и магнитных структур, причем как по чувствительности, так и по спектральному разрешению, что в итоге позволило значительно углубить понимание связи между экситонными состояниями и их проявлением в ГВГ спектрах.

Фемтосекундная методика была применена для изучения ГВГ в CuB_2O_4 в работах [70, 78], и ниже мы рассмотрим основные результаты спектроскопического исследования согласно статье [70]. На рис. 17 приведены результаты при распространении света в направлении $\mathbf{k} \parallel y$ при двух температурах. При T = 4.0 К изменение направления магнитного поля на противоположное приводит к существенному изменению всей структуры спектра ГВГ. Например, для линии 1.4062 эВ изменение интенсивности достигает почти 100%, что позволяет говорить о гигантской невзаимности. В спектрах ГВГ хорошо различимы четыре интенсивные линии, или точнее две пары дублетов, но имеются еще две слабые пары дублетов. И действительно, исследование линейного по интенсивности поглощения на френкелевских экситонах в этой же спектральной области говорит о том, что линий действительно больше, как было показано выше на рис. 12 [60]. Можно заключить, что две пары интенсивных линий в спектрах ГВГ на рис. 17 соответствуют двум интенсивным дублетам экситонов в спектрах поглощения на рис. 12.

Следует обратить внимание на то, что, с одной стороны, имеется хорошее согласие по спектральному положению отдельных линий в двух типах спектров, но с другой стороны, такое заключение не применимо в отношении соответствующих интенсивностей. Более того, интенсивности ГВГ линий существенно зависят от знака поля, как показано на рис. 17, т.е. имеет место полевая невзаимность, которая в спектрах поглощения не наблюдалось. Такое важное различие можно предположительно связать с тем, что в случае не когерентного поглощения имеет место суммирование интенсивностей, обусловленных разными механизмами, а в случае когерентной ГВГ имеет место интерференция, которая может быть как синфазной, так и противофазной. При повышении температуры от T = 4.0 K до T = 12.5 K характер спектральной зависимости су-



Рис. 17. (Цветной онлайн) Спектральные зависимости невзаимной ГВГ в CuB₂O₄, измеренные для образца в (xz)плоскости при распространении света вдоль направления k_y , поляризации накачки E_z^{ω} и температурах T = 4.0 K (a) и T = 12.5 K (b). Розовые и фиолетовые зависимости ГВГ были измерены для противоположных направлений магнитного поля. Красные и синие азимутальные зависимости (c) и (d) соответствуют поляризациям $\mathbf{E}^{\omega} \perp \mathbf{E}^{2\omega}$ и $\mathbf{E}^{\omega} \parallel \mathbf{E}^{2\omega}$, соответственно. Рисунки приведены согласно статье [70] с разрешения American Physical Society

щественно изменяется, но невзаимность остается хорошо выраженной. Светло-зеленые и желтые вставки показывают вращательные диаграммы анизотропии двух групп G1 и G2 сигналов ГВГ для двух основных комбинаций поляризации накачки и ГВГ и для противоположных магнитных полей, соответственно.

Симметрийный анализ нелинейных восприимчивостей показал (см. дополнительный материал к статье [70], что кристаллографический ЭД *С*-вклад в ГВГ отсутствует при нормальном падении луча света накачки на ориентированную пластинку CuB_2O_4 . В геометрии **В** $\parallel x$ для объяснения наблюдаемой невзаимности необходимо привлечь интерференцию двух источников ГВГ, показанных на рис. 16. Первый связан с внешним магнитным полем,

$$E_x^{2\omega} \propto (E_z^{\omega})^2 B_x,$$

а второй — с тороидным моментом [79,80]

$$\mathbf{E}^{2\omega} \propto (E_z^{\omega})^2 \mathbf{T}.$$

В отсутствие магнитного поля антиферромагнитные спины 4*b*-ионов Cu^{2+} направлены по осям типа [110] в случае однодоменного образца, и тогда тороидный момент в CuB_2O_4 , согласно [70], равен

$$\mathbf{T} = L_y \mathbf{x} - L_x \mathbf{y}.\tag{3}$$

Из этого выражения следует, что тороидный момент \mathbf{T} максимален при ориентации вектора \mathbf{L} вдоль кристаллографической оси [110], но он обращается в нуль при ориентации вдоль оси [010] при вращении в плоскости (001). При дальнейшем вращении тороидный момент \mathbf{T} меняет знак, т.е. имеет место периодическое изменение величины и знака \mathbf{T} по синусоидальному закону двойного угла вращения \mathbf{T} .

В применении к CuB_2O_4 невзаимность описывается выражением

$$|E^{2\omega}(\boldsymbol{B})|^2 - |E^{2\omega}(-\boldsymbol{B})|^2 \propto B_x T_x |E_z^{\omega}|^4.$$
 (4)

Это выражение показывает, что сигнал ГВГ изменяется при переключении магнитного поля на противоположное направление, т. е. возникает невзаим-



Рис. 18. (Цветной онлайн) Спектры ГВГ в (xz)-пластинке Си B_2O_4 при (а) нормальном падении k || y в геометрии Фохта, $E^{\omega} \parallel z, E^{\omega} \perp E^{2\omega}$ в магнитном поле $B_z = \pm 5$ Тл, (b) для образца, повернутого на угол 5° в положительном (c) и отрицательном (d) направлениях вокруг оси x. На левой вставке на (a) показана вращательная анизотропия ГВГ для интенсивного пика G2 при $E^{\omega} \perp E^{2\omega}$ (розовые символы) и $E^{\omega} \parallel E^{2\omega}$ (фиолетовые символы); такого же типа анизотропии наблюдались в случаях (b) и (c). Полевые зависимости ГВГ для линии G2 существенно различаются во всех трех случаях, как показано на вставках справа на рисунках (a), (b) и (c). Рисунки приведены согласно статье [70] с разрешения Аmerican Physical Society

ность, которая пропорциональна и полю, и тороидному моменту. Отметим, что это выражение справедливо только в соразмерной магнитной фазе, поскольку в несоразмерной фазе [17,18] тороидный момент \mathbf{T} обращается в нуль.

Интерференция нескольких механизмов ГВГ в CuB_2O_4 хорошо проявляется в том случае, когда в дополнение к магнитополевому В и тороидному Т механизмам, примешивается еще и кристаллографический механизм С (рис. 16). По соображениям симметрии этот механизм ГВГ может реализоваться в том случае, когда поляризация света накачки отклоняется от направлений главных кристаллографических осей, что приводит к интересному результату, показанному на рис. 18. При нормальном падении света накачки и выходящей из кристалла гармоники при $\mathbf{k} \parallel y$, в геометрии на рис. 18(a) реализуется только один механизм ГВГ, связанный с магнитным полем, и, поскольку интерференция отсутствует, отсутствует и невзаимность ГВГ при изменении направления поля на противоположное, $B_z = \pm 5$ Тл.

Сигнал ГВГ резко изменяется по спектральному виду и по интенсивности, если образец (xz) повернуть на некоторый угол вокруг оси x, когда сохраняется условие $\mathbf{B} \perp \mathbf{k}$. На рис. 18(b, c) показаны результаты при повороте образца на угол $\pm 5^{\circ}$. Однако при таком повороте образца \mathbf{k} -векторы света накачки и ГВГ уже не совпадают с осями y и z. В результате интенсивность и спектральный отклик ГВГ возрастают, причем, по-разному для положительного и отрицательного вращения образца вокруг оси x, как это показано на рис. 18(b) и (c), соответственно. Сильный рост интенсивности ГВГ примерно в пять раз является явным свидетельством активации сильного кристаллографического *C*-вклада, и при этом реализуется возможность для интерференции *C*- и **B**-вкладов и для возникновения невзаимности ГВГ.

Кроме сильного роста интенсивности радикально изменяется спектральная зависимость ГВГ, причем по-разному для положительного и отрицательного поворотов кристалла вокруг оси x. Асимметричность спектров ГВГ при таких поворотах является однозначным свидетельством резонанса Фано [45]. В рассматриваемом случае имеет место интерференция кристаллографического C-вклада, который не зависит от знака магнитного поля, и линейного по полю магнитного **В**-вклада в ГВГ. Важно отметить, что в этой геометрии асимметрия спектра инвертируется как при вращениях кристалла относительно оси x в противоположные стороны, так и при изменении направления магнитного поля на противоположное.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние два десятилетия метаборат меди CuB_2O_4 с уникальной для магнитных кристаллов нецентросимметричной кристаллической структурой $\overline{42m}$ и сложной магнитной фазовой диаграммой ниже температуры магнитного упорядочения $T_N = 21$ К стал предметом активных его магнитных и оптических свойств. На настоящий момент

исследований этот материал остается уникальным в семействе метаборатных магнитных диэлектриков на основе $3d^n$ ионов, поскольку все другие известные диэлектрики типа AB_2O_4 , где A есть металл переходной группы, кристаллизуются в других структурах. Известно лишь несколько исключений. Так, кристаллическая структура CuB_2O_4 с точечной группой $\overline{4}2m$ сохраняется при небольшом замещении ионов Cu^{2+} ионами Ni^{2+} и Mn^{2+} , но остается открытым вопрос, сохраняется ли эта структура при замещении иона Cu^{2+} этими и другими магнитными ионами в больших концентрациях. Другое единственное известное исключение представляет метаборат рутения PdB_2O_4 , но его физические свойства на сегодняшний день остаются не исследованными.

В статье рассмотрены теоретические результаты по взаимному и невзаимному распространению и поглощению света, полученные на основе решений уравнений Максвелла. Теоретический анализ был проведен с учетом особенностей кристаллической и магнитной структуры этого кристалла в парамагнитной области и в упорядоченной соразмерной магнитной фазе во внешнем магнитном поле.

Динамика кристаллической решетки была изучена с использованием ИК- и КРС-спектроскопии, что позволило определить симметрию большинства четных и нечетных фононов. Теоретическое исследование фононов в центре зоны Бриллюэна было проведено с использованием первопринципных расчетов и позволило дать надежную симметрийную идентификацию всех наблюдаемых фононов.

Исследования оптического поглощения в области электронных переходов между $3d^9$ -состояниями в кристаллическом поле были проведены с использованием поляризационной спектроскопии высокого разрешения. Эти исследования показали, что, в отличии от ранее изучавшихся фторидных и оксидных магнитных диэлектриков с $3d^n$ ионами, CuB_2O_4 характеризуется уникальными спектрами, охватывающими все возможные оптические переходы в обеих 4b- и 8d-подсистемах ионов Cu^{2+} . Важным результатом также является существенно различное поляризационное и температурное поведение БФ-линий в этих двух подсистемах.

Ярким оптическим проявлением нецентросимметричности кристаллической структуры CuB₂O₄ явилось наблюдение невзаимности оптического поглощения, определяемого как различие в коэффициентах поглощения при изменении знака внешнего магнитного поля. Это явление наблюдалась на всех электронных переходах в обеих магнитных подсистемах ионов меди. Оптические исследованию в магнитных полях показали, что модель кристаллического поля оказывается недостаточной для объяснения тонкой структуры спектров поглощения, и это потребовало введения в рассмотрение концепции экситонов Френкеля. Эта концепция позволила достичь хорошего согласия между экспериментальными результатами и теоретической экситонной моделью.

Были изучены спектры Φ Л, которые наблюдались в широком диапазоне 1.2–1.4 эВ ниже первой экситонной линии. Сложная структура этих спектров получила объяснение в предположении о существовании в CuB₂O₄ нескольких локализованных экситон-магнонных состояний, некоторые из которых наблюдались при температурах выше T_N .

Интенсивные сигналы ГВГ ЭД- и МД-природы, обусловленные нецентросиметричностью кристаллической структуры и характером магнитного упорядочения CuB_2O_4 , были исследованы в области экситонных переходов и фононных сателлитов. Наблюдались яркие проявления резонанас Фано, вызванные интерференцией между тороидным, магнитным и кристаллографическими вкладами в интенсивность ГВГ.

Благодарности. Авторы глубоко признательны всем многочисленным соавторам совместных публикаций по CuB₂O₄.

Финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 19-52-12063.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Д. И. Менделеев, *Основы химии*, 8-е изд., С. Петербург (1906).
- M. Martinez-Ripoll, S. Martinez-Carrera, and S. Garcia-Blanco, Acta Cryst. B 27, 677 (1971).
- R. V. Pisarev, K. N. Boldyrev, M. N. Popova, A. N. Smirnov, V. Yu. Davydov, L. N. Bezmaternykh, M. B. Smirnov, and V. Yu. Kazimirov, Phys. Rev. B 88, 024301 (2013).
- 4. K. N. Boldyrev, A. D. Molchanova, A. R. Nurmukhametov, M. V. Eremin, R. V. Pisarev, and M. N. Popova, Magnetochemistry 9, 95 (2023).
- G. K. Abdullaev and K. S. Mamedov, J. Struct. Chem. 22, 637 (1981).

- W. Depmeier, H. Schmid, and F. Haenssler, Naturwissenschaften, 67, 456 (1980).
- W. Depmeier and H. Schmid, Acta Cryst. B 38, 605 (1982).
- J. Schlüter, D. Pohl and U. Golla-Schindler, N. Jb. Miner., 185/1, 27 (2008).
- G. A. Petrakovskii, K. A. Sablina, L. V. Udod, A. I. Pankrats, D. A. Velikanova, R. Szymczak, M. Baran, G. V. Bondarenko, J. Magn. Magn. Mat., 300, e476–e478 (2006).
- 10. N. D. Khanh, N. Abe, K. Kubo, M. Akaki, M. Tokunaga, T. Sasaki, and T. Arima, Phys. Rev. B 87, 184416 (2013).
- А. Д. Молчанова, Е. М. Мошкина, М. С. Молокеев, Е. В. Тропина, А. Ф. Бовина, К. Н. Болдырев, Оптика и спектроскопия 130, 111 (2022)
 [A. D. Molchanova, Е. М. Moshkina, M. S. Molokeev, E. V. Tropina, A. F. Bovina, K. N. Boldyrev, Optics and Spectroscopy 130, 105 (2022)].
- A. D. Molchanova, K. N. Boldyrev, A. S. Erofeev, E. M. Moshkina, and L. N. Bezmaternykh, J. Phys.: Conf. Ser. 917, 072003 (2017).
- **13**. I. B. Bersuker, *The Jahn-Teller effect*, Cambridge University Press (2006).
- 14. H. Behm, Acta Cryst. B B38, 2781 (1982).
- A. D. Molchanova, M. A. Prosnikov, R. M. Dubrovin, V. Yu. Davydov, A. N. Smirnov, R. V. Pisarev, K. N. Boldyrev, and M. N. Popova, Phys. Rev. B 96, 174305 (2017).
- Е. М. Мошкина, Н. А. Бельская, М. С. Молокеева, А. Ф. Бовина, К. А. Шабанова, Д. Кох, Ю. В. Сереткин, Д. А. Великанова, Е. В. Еремин, А. С. Крылов, Л. Н. Безматерных, ЖЭТФ
 163, 24 (2023) [Е. М. Moshkina, N. A. Belskaya, M. S. Molokeev, A. F. Bovina, K. A. Shabanova, D. Kokh, Yu. V. Seretkin, D. A. Velikanov, E. V. Eremin, A. S. Krylov and L. N. Bezmaternykh, J. Exp. Theor. Phys. 163, 17 (2023)].
- M. Boehm, B. Roessli, J. Schefer, A. S. Wills, B. Ouladdiaf, E. Lelièvre-Berna, U. Staub, and G. A. Petrakovskii, Phys. Rev. B 68, 024405 (2003).
- A. E. Петрова, A. И. Панкрац, ЖЭТФ, 153, 607 (2018) [A. E. Petrova, A. I. Pankrats, J. Exp. Theor. Phys. 126, 506 (2018)].

- 19. T. Kawamata, N. Sugawara, S. M. Haider, and T. Adachi, et al, J. Phys. Soc. Jpn. 88, 114708 (2019).
- 20. С. Н. Мартынов, Письма в ЖЭТФ 90, 60 (2009)
 [S. N. Martynov, JETP Letters 90, 55 (2009)].
- 21. С. Н. Мартынов, ЖЭТФ 135, 82 (2009)
 [S. N. Martynov, J. Exp. Theor. Phys., 108, 72 (2009)].
- 22. С. Н. Мартынов, ЖЭТФ 136, 1134 (2009)
 [S. N. Martynov, J. Exp. Theor. Phys., 109, 979 (2009)].
- 23. G. Nénert, L. N. Bezmaternykh, A. N. Vasiliev, and T. T. M. Palstra, Phys. Rev. B 76, 144401 (2007).
- 24. М. В. Еремин, А. Р. Нурмухаметов, Письма в ЖЭТФ, 114, 31 (2021) [М. V. Eremin, А. R. Nurmukhametov, JETP Letters, 114, 35 (2021)].
- 25. А. Р. Нурмухаметов, М. В. Еремин, ЖЭТФ 162, 390 (2022) [А. R. Nurmukhametov, М. V. Eremin, J. Exp. Theor. Phys. 135, 339 (2022)].
- 26. M. Saito, K. Ishikawa, K. Taniguchi, and T. Arima, Phys. Rev. Lett. 101, 117402 (2008).
- 27. H. D. Flack, Acta Cryst. Sect. A 65, 371 (2009).
- **28**. International Tables for Crystallography, Volume A: Space Group Symmetry, Th. Hahn, Editor, Springer (2002).
- 29. S. F. Mason, Molecular optical activity and the chiral discriminations, Cambridge University Press, New York (1982).
- 30. S. W. Lovesey and U. Staub, J. Phys.: Condens. Matter 21, 142201 (2009).
- T. Arima and M. Saito J. Phys.: Condens. Matter 21, 498001 (2009).
- 32. S. W. Lovesey and U. Staub J. Phys.: Condens. Matter 21, 498002 (2009).
- 33. S. W. Lovesey, Phys. Rev. B 94, 094422 (2016).
- 34. A. K. Zvezdin and V. A. Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, CRC Press, Taylor and Francis (1997).
- 35. A. I. Nikitchenko and R. V. Pisarev, Phys. Rev. B 104, 184108 (2021).

- **36.** V. M. Agranovich and V. L. Ginsburg, *Crystal optics with spatial dispersion and excitons*, Wiley (1985).
- 37. V. G. Ivanov, M. V. Abrashev, N. D. Todorov, V. Tomov, R. P. Nikolova, A. P. Litvinchuk, and M. N. Iliev, Phys. Rev. B 88, 094301 (2013).
- 38. V. Tomov, P. M. Rafailov, and L. Yankova, J. Phys.: Conf. Ser. 682, 012028 (2016).
- **39**. A. S. Davydov, *Theory of Molecular Excitons*, Plenum, New York (1971).
- 40. S. Sahoo, P. Malavi, and S. Karmakar, Phys. Rev. B 107, 094411 (2023).
- 41. K. Imasaka, R. V. Pisarev, L. N. Bezmaternykh, T. Shimura, A. M. Kalashnikova, and T. Satoh, Phys. Rev. B 98, 054303 (2018).
- 42. Yong-Xin Yan, Edward B. Gamble, Jr., and Keith A. Nelson, J. Chem. Phys. 83, 5391 (1985).
- 43. Г. А. Смоленский, Р. В. Писарев, И. Г. Синий, Усп. физ. наук 116, 231 (1975) [G. A. Smolenskii, R. V. Pisarev, and I. G. Sinii, Usp. Fiz. Nauk 18, 410 (1975)].
- 44. J. Ferré and G. A. Gehring, Rep. Prog. Phys. 47, 513 (1984).
- 45. U. Fano, Phys. Rev. 124, 1866 (1961).
- 46. R. V. Pisarev, I. Sänger, G. A. Petrakovskii, and M. Fiebig, Phys. Rev. Lett. 93, 037204 (2004).
- 47. R. V. Pisarev, A. M. Kalashnikova, O. Schöps, and L. N. Bezmaternykh, Phys. Rev. B 84, 075160 (2011).
- 48. R. G. Burns, Mineralogical Applications of Crystal Field Theory, Cambridge, 2nd Edition (1993).
- **49**. Olev Sild, Kristjan Haller (Eds.), Zero-Phonon Lines: And Spectral Hole Burning in Spectroscopy and Photochemistry, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2011).
- 50. D. S. McClure, Electronic Spectra of Molecules and Ions in Crystals, Part II, Solid State Phys. 9, 399-525; F. Seitz, D. Turnbull (Eds.), Academic Press Inc., New York.
- 51. R. D. Mero, C.-H. Lai, C.-H. Du, and H.-L. Liu, J. Phys. Chem. C 125, 4322 (2021).

- 52. S. Toyoda, N. Abe, and T. Arima, Phys. Rev. B 93, 201109(R) (2016).
- 53. S. Toyoda, N. Abe, and T. Arima, Phys. Rev. Lett. 123, 077401 (2019).
- 54. R. L. Greene, D. D. Sell, W. M. Yen, A. L. Schawlow, R. M. White, Phys. Rev. Lett. 15, 656 (1965).
- 55. J. W. Allen, R. M. Macfarlane, and R. L. White, Phys. Rev. 179, 523 (1969).
- 56. R. Loudon, Adv. Phys. 17, 243 (1968).
- 57. V. V. Eremenko, E. G. Petrov, Adv. Phys. 26, 31 (1977).
- 58. Y. Tanabe and K. Aoyagi, *Excitons in Magnetic Insulators*, Ch.14 in Excitons, Ed. by E. I. Rashba and M. D. Sturge, North-Holland Publishing Company (1982).
- 59. B. Henderson and G. F. Imbusch, Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, Oxford University Press, New York, (1989).
- 60. N. E. Kopteva, D. Kudlacik, D. R. Yakovlev, M. V. Eremin, A. R. Nurmukhametov, M. Bayer, and R. V. Pisarev, Phys. Rev. B 105, 024421 (2022).
- 61. K. N. Boldyrev, R. V. Pisarev, L. N. Bezmaternykh, and M. N. Popova, Phys. Rev. Lett. 114, 247210 (2015).
- 62. В. В. Меньшенин, ЖЭТФ 151, 326 (2017) [V. V. Menshenin, J. Exp. Theor. Phys. 124, 279 (2017)].
- J. Frenkel, Phys. Rev. 37, 17 (1931); Phys. Rev. 37, 1276 (1931).
- 64. T. Maiman, Nature 187, 493 (1960).
- 65. G. F. Imbusch, R. Kopelman, Optical Spectroscopy of Electronic Centers in Solids, pages 1-37 in Laser Spectroscopy of Solids, W. M. Yen, P. M. Selzer (Eds.).
- 66. G. F. Imbusch, Luminescence from solids with high concentrations of transition metal ions, in Luminescence of Inorganic Solids, edited by D. Bartolo, V. Goldberg, and D. Pacheco (Springer, Boston, 1978), pp. 155–180.
- 67. R. E. Dietz, A. Misetich, Optical Spectroscopy of Electronic Centers in Solids, pages 366-385 in Laser Spectroscopy of Solids, W. M. Yen, P. M. Selzer (Eds.).

- 68. D. Kudlacik, V. Yu. Ivanov, D. R. Yakovlev, V. F. Sapega, J. J. Schindler, J. Debus, M. Bayer, and R. V. Pisarev, Phys. Rev. 102, 035128 (2020).
- 69. D. Kudlacik, Absorption und Photoluminesczenspectroskopie an CuB₂O₄, Masterarbeit, Technische Universität Dortmund (2013).
- 70. J. Mund, D. R. Yakovlev, A. N. Poddubny, R. M. Dubrovin, M. Bayer, and R. V. Pisarev, Phys. Rev. B 103, L180410 (2021).
- 71. Y. R. Shen, The Principles of Nonlinear Optics, Wiley Classics Library (2003).
- 72. R. W. Boyd, Nonlinear Optics, 3d edition, Academic Press (2020).
- 73. M. Fiebig, D. Fröhlich, Th. Lottermoser, V. V. Pavlov, R. V. Pisarev, and H.-J. Weber, Phys. Rev. Lett. 87, 137202 (2001).

- 74. M. Fiebig, Th. Lottermoser, V. V. Pavlov and R. V. Pisarev, J. Appl. Phys. 93, 6900 (2003).
- 75. M. Fiebig, D. Fröhlich, Th. Lottermoser, V. V. Pavlov, R. V. Pisarev, and H.-J. Weber, J. Magn. Magn. Mat. 258–259, 110 (2003).
- 76. M. Fiebig, R. V. Pisarev, J. Magn. Magn. Mat. 272–276, e1607 (2004).
- 77. M. Fiebig, V. V. Pavlov, and R. V. Pisarev, J. Opt. Soc. Am. 22, 96 (2005).
- 78. S. Toyoda, M. Fiebig, T.-H. Arima, Y. Tokura, and N. Ogawa, Sci. Adv. 7, sciadv.abe2793 (2021).
- 79. V. M. Dubovik, V. V. Tugushev, Physics Reports 187, 145 (1990).
- 80. S. Nanz, Toroidal Multipole Moments in Classical Electrodynamics, Springer Spektrum, Wiesbaden (2016).